

Magnetoresistiv hat Zukunft

Erweiterte Messmöglichkeiten durch neue Prinzipien

Wenn Sensoren für magnetische Felder heute in Millionenstückzahlen zu Cent-Preisen hergestellt werden, dann bedeutet das keineswegs einen technologischen Stillstand. Ganz im Gegenteil, die neuen Ideen für verbesserte Funktion sprudeln munter weiter. In Konkurrenz zu den verbreiteten Hallensensoren stehen die magnetoresistiven. Unter diesen kommen jetzt neben den altbewährten AMR- die neuen GMR-Typen immer häufiger zur Anwendung. Andererseits

siert auf dem „Anisotropen Magneto-Resistiven“ Effekt, entdeckt 1857 von William Thomson (Lord Kelvin). Das erste Patent hierauf meldete Ampex, USA, 1966 an. Die Großserienproduktion begann in den 80-er Jahren. Magnetisch hochpermeable Legierungen wie Mu-Metall oder Permalloy ändern im Magnetfeld ihren elektrischen Widerstand, wobei der Winkel zwischen Magnetisierungsrichtung und Stromrichtung eine entscheidende Rolle spielt. Verlaufen beide parallel, ist der Effekt am stärksten. Der Vorteil gegenüber den Hallensensoren: Der eigentliche Sensorteil enthält keine Halbleiternur nur Metalle; dadurch ist der Temperaturbereich größer. Der notwendige Auswerteelektronik in einiger Entfernung, wo es weniger heiß ist. Der Effekt hat allerdings einige ungünstige Eigenschaften, die ihn für eine Nutzung zunächst schwer gelassen: Die Widerstände sind proportional zum magnetischen Feldstärke maximal etwa 3 %. Zu diesem Erfolg kamen derartige Sensoren erst, nachdem es gelungen war, die störenden Effekte zu kompensieren. Dazu bedurfte es einer Reihe von ausgeklügelten Schaltungen wie Brückenschaltung von vier Sensorelementen, Vormagnetisierung und diagonal aufgebrachte Bahnen aus hochleitfähigem Metall („Barberpol“-Strukturen). Die starke Nichtlinearität

Der große kommerzielle Erfolg der Magnetfeldsensoren beruht darauf, dass sie in den meisten Fällen „zweckentfremdet“ werden. Nur in einer Minderzahl von Anwendungen ist die Messung der magnetischen Flussdichte die ursprüngliche Absicht. Sehr häufig dienen sie als physikalische Weg, um letztlich ganz andere Größen zu erfassen; darunter vor allem mechanische wie Position, Verschleißweg, Winkel, Drehzahl, Füllstand usw., oft auch einfach nur die An- oder Abwesenheit eines Gegenstandes (z.B. „Autotür geschlossen?“). Ebenso gut wäre dies auch auf mechanischem oder optischem Wege möglich. Sehr vielen Anwendern ist das physikalische Prinzip egal; worauf es ihnen weit mehr ankommt, sind höchste Zuverlässigkeit, kleines Bauvolumen, hohe Genauigkeit und Linearität, Verschleißfreiheit, geringe Stromaufnahme und niedrige Kosten. In dieser Hinsicht erweisen sich die magnetischen Verfahren als besonders günstig.

Weit verbreitet sind die Hallensensoren – heute komplexe ICs mit interner Signalverarbeitung inkl. Temperatur- und Offsetkompensation sowie Programmierbarkeit der Parameter [3]. Sie haben allerdings einige Einschränkungen: Ihr Temperaturbereich ist be-

Der älteste und am weitesten verbreitete Typ ist der AMR-Sensor; er ba-

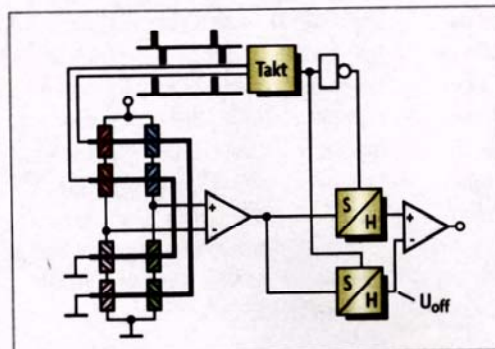
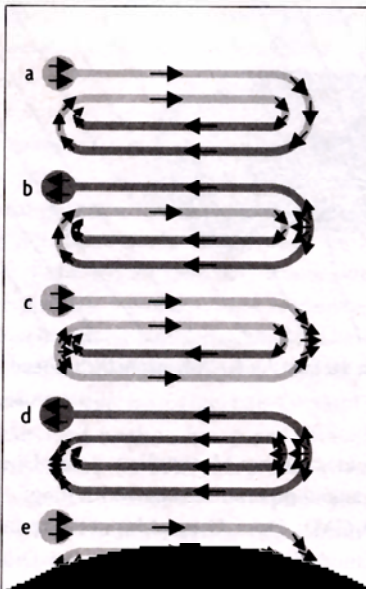


Bild 1. Neuartiger geflippter MR-Sensor mit geteiltem Flip-Leiter. Damit lässt sich die obere Grenzfrequenz bis auf etwa 1 MHz steigern.

(Quelle: Sensitec)

eliminiert man mit Hilfe einer geschlossenen Regel-schleife: Eine zusätzliche stromdurchflossene Spule erzeugt ein Magnetfeld, welches das zu messende Feld gerade eben kompensiert. So arbeiten die AMR-Elemente immer in unmittelbarer Nähe ihres Nullpunktes. Um den Offset zu minimieren, hat man das „Flippen“ eingeführt: Die Richtung der Vormagnetisierung wird periodisch gewechselt; so wird

I Bild 7. Prinzip des GMR-Umdrehungszählers, hier mit zwei Windungen für zwei Umdrehungen (720°): a) Beginn bei 0° mit keiner Domänenwand in der Spirale, hier sind zwei gerade Teile des Streifens parallel und zwei antiparallel zur Referenzrichtung des GMR-Schichtstapels. b) nach 180° Feldrotation: In der vergrößerten Fläche wurde eine Domänenwand erzeugt und zur ersten Kurve geschoben, dadurch wurde die Magnetisierung der ersten geraden Streifens umgekehrt. Jetzt sind drei Streifen antiparallel und einer parallel zur Referenzrichtung. c) Magnetisierungszustand nach Magnetfeldrotation um 360°; es wurde eine zweite 180°-Domänenwand erzeugt und zur ersten Windung geschoben. Die Magnetisierungsrichtung des ersten Streifens ist umgedreht zu parallel. Gleichzeitig wurde die zuerst erzeugte 180°-Domänenwand von der ersten zur zweiten Kurve verschoben, dadurch wurde die Magnetisierung des zweiten Streifens auf antiparallel umgedreht. Nach 360° Drehung sind also drei gerade Stücke parallel magnetisiert und einer antiparallel. d) Magnetisierung nach 540° Drehung, wo insgesamt drei Domänenwände erzeugt und in der Spirale weiterschoben worden sind. Jetzt sind vier Streifen antiparallel magnetisiert. e) Nach 720° = zwei volle Umdrehungen sind vier Domänenwände in der Spirale gespeichert, alle vier geraden Stücke sind parallel magnetisiert.



(Quelle: IPHT)

teil, wie z.B. von Sensitec
Störungen durch externe M

von Sensitec sind ein kompakterer Aufbau, SMD-Bestückbarkeit und nur noch eine einzelne Versorgungsspannung von 5 V. In Entwicklung befinden sich geflippte Typen, bei denen der Offset wesentlich kleiner und damit die Messdynamik weiter werden wird [1].

Ein aussichtsreiches Anwendungsfeld für MR-Sensoren eröffnet sich möglicherweise in der Verkehrsdatenerfassung. Ein an der Universität des Saarlandes aufgebautes experimentelles System stellt die Anwesenheit eines Fahrzeugs über die Messung der Verformung des Erdmagnetfeldes fest (Bild 5). Diese beträgt hier nur wenige Prozent; so kleine Veränderungen lassen sich mit MR-Sensoren noch sicher erfassen. Zur Messung aller drei Feld-

komponenten braucht man drei orthogonal angeordnete Sensorelemente.

Die Messpunkte in definiertem Abstand können sich auch Geschwindigkeitsfahrtrichtung feststellen.

Das fahrende Fahrzeug erzeugt ein „virtuelles Fingerabdruck“, das teilweise auch die

Identifizierung (Pkw, Lkw, Bus) ermöglicht. Über den bisher verwendeten Induktionsschleifen in der

erhöhen die MR-Sensoren den Lebensdauer und die

Verfügbarkeit bei fließendem Verkehr. Die Empfindlichkeit reicht weit. Die Saarländer haben

MR-, GMR- und TMR-Sensoren eingesetzt. Die Probleme mit Streuungen, Temperaturabhängigkeit und eingestreuten Störungen ließen sich durch

intelligente Signalverarbeitung weitgehend eliminieren. Ein Prototypsystem mit 108 Sensoren auf dem Boden und an den Wänden wurde in einem Parkhaus installiert, um die Zahl der freien Parkplätze zu ermitteln. Der Autofahrer kann sie auf einem Display über der Einfahrt ablesen [1].

Am Institut für Angewandte Physik der Universität Gießen nutzt man MR-Sensoren zur zerstörungsfreien Materialprüfung. Über induzierte Wirbelströme lassen sich damit Inhomogenitäten detektieren. Dank ihrer Kleinheit erzielen die Sensoren eine sehr hohe örtliche Auflösung und ein sehr gutes Signal/Rausch-Verhältnis. Als besonders geeignet haben sich GMR- und TMR-Sensoren erwiesen.

**ELEKTRO
KNOW-H**

PC & Elektronik

Das ganze Wissen für Mechatronik auf über 1300 Seiten

PC-Mechatronik Labor

Praxisnahes Lernen mit dem PC als Simulationssystem

Auf DVD:

- Schaltplanerstellung und Elektriksimulation
- Konstruktionssoftware
- Simulationssoftware
- und vieles mehr

FRANZIS

ISBN 978-3-7071-4188-5
€ 39,95

WWW.FRANZIS.DE

gegen-
gesetzt gepolte Magnetfelder erzeugt (Bild 4). Damit addieren sich die von beiden Halbbrücken zweigen abgegebenen Signalspannungen.

Stromsensoren dieser Art sind seit mehreren Jahren in Serienproduktion. Auch hier verbleibt ein gewisser Offsetfehler, der von der Temperatur abhängt und die Genauigkeit am unteren Ende des Messbereichs verringert. Die wesentlichen Verbesserungen bei der neuen Serie CDS4000

ordnung der Atome und Moleküle kommen, reichen die Gesetze der klassischen Physik bekanntlich nicht mehr aus, um die Vorgänge zu beschreiben. So beginnt z.B. eine Isolatorschicht zwischen zwei leitenden Schichten Ladungsträger durchzulassen, wenn sie nur dünn genug wird (einige nm). Der TMR-Effekt tritt auf, wenn sich der Isolator zwischen zwei ferromagnetischen Schichten befindet. Sind beide zueinander gleichsinnig magnetisiert, ist der resultierende Gesamtwiderstand niedrig; bei gegensinniger Ausrichtung (antiferromagnetisch) ist er hoch. Das hängt mit der Spinpolarisation der Leitungselektronen zusam-

der Elektroden magnetisch auszurichten („pinnen“), wird analog zu den GMR-Spinvalves ein Antiferromagnet, beispielsweise IrMn oder PtMn, angebracht. Dieser koppelt an eine der beiden Elektroden an und fixiert die Magnetisierung der Elektrode in eine vorgegebene Richtung.

Die wesentlichen Unterschiede gegenüber GMR-Sensoren sind: Statt einer koppelnden Kupferschicht sitzt ein Nichtleiter zwischen den beiden ferromagnetischen Schichten, und der Strom fließt nicht parallel zu diesen, sondern senkrecht dazu. In Bild 3 sind beide gegenübergestellt. Während ein auf AMR- oder GMR-Technologie ba-

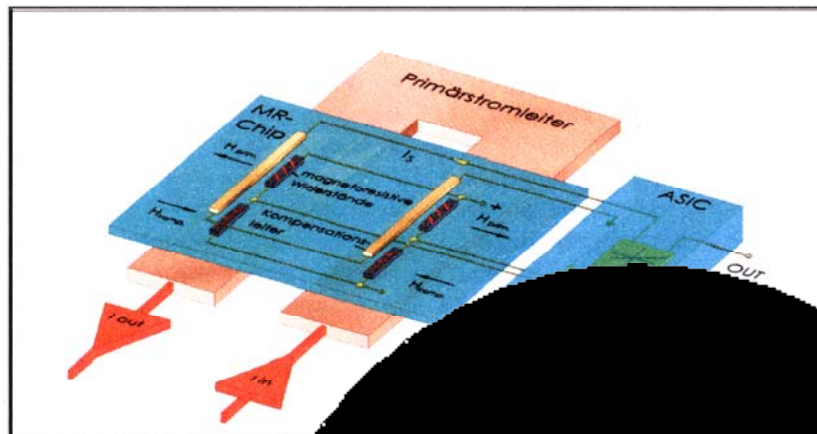


Bild 4. Prinzip des magnetoresistiven Einfluss.

men, die in Metallen eine Vorzug. Tunneln die Elektronen durch die Barriere, sie sich auf der gegenüberliegenden Elektrode plötzlich in. Das bedeutet, dass sie keine Plätze finden und nicht gut beitragen [1].

Der TMR-Effekt ist seit den 70-er Jahre bekannt. Zu Beginn der Forschung war er jedoch nur in kleinen Mengen herzustellen, es war nicht möglich, reproduzierbar gute Proben herzustellen. Erst in den letzten Jahren sind entscheidende Durchbrüche mit Widerstandsänderungen bis zu 300 % gelungen, z.B. bei Sensitec. Im konkreten Aufbau besteht ein magnetisches Tunnелеlement (MTJ = Magnetic Tunnel Junction) aus zwei ferromagnetischen Elektroden, typischerweise aus CoFe, NiFe oder CoFeB, zwischen denen sich eine dünne Isolatorschicht befindet, beispielsweise aus Al_2O_3 oder MgO. Um eine

Temperaturbereich, in dem eine höhere Ortsauflösung erreichbar ist, als bei GMR und AMR, was für Verfahren der magnetischen Bildgebung von großem Vorteil sein könnte. Durch Variation der Schichtdicke und der Fläche der Barriere kann der elektrische Widerstand des TMR-Elements um Größenordnungen variiert werden. Schließlich halten TMR-Sen-

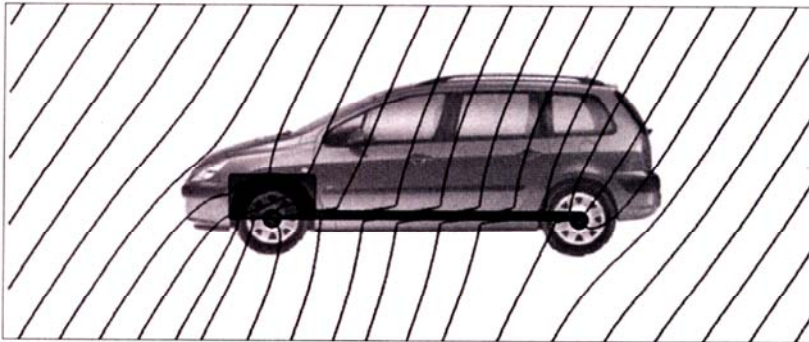


Bild 5. Die Verbiegung der magnetischen Feldlinien der Erde durch einen magnetisch leitenden Gegenstand lässt sich mit MR-Sensoren messen. (Bild: UniSaarland)

soren auch höheren Temperaturen stand als ihre AMR- und GMR-Konkurrenten. Die genannten Eigenschaften lassen ein breites potentielles Anwendungsfeld erwarten.

■ Noch andere magneto-resistive Effekte

In den Labors schlummern noch viele weitere Ideen; welche davon den richtigen Weg bis zu einem industriellen Produkt schaffen werden, ist im Moment nicht klar absehbar. Auf jeden Fall wird an allen intensiv weiter gearbeitet, wobei deutsche Firmen und Institute technologisch mit dem Weltweit mithalten können. Die folgende Sammelbezeichnung „XMR“. Außer den schon genannten fallen hierunter noch:

► **CMR:** Der „Colossale-Magneto-resistive“-Effekt ist ein Volumeneffekt, der vor allem in perowskitischen Materialien auftritt. Bei Temperaturen in der Nähe ihrer Übergangstemperatur vom metallischen zum Halbleiter-Verhalten wurden Widerstandsänderungen von mehr als 200 % beobachtet –

leider nur bei Materialien, deren Übergangstemperatur unter 100 K liegt.

► **GMI:** Der „Giant-Magnetic-Inductance“-Effekt tritt vor allem an Drähten auf, die eine Oberflächenschicht aus einem ferromagnetischen Material besitzen. S...

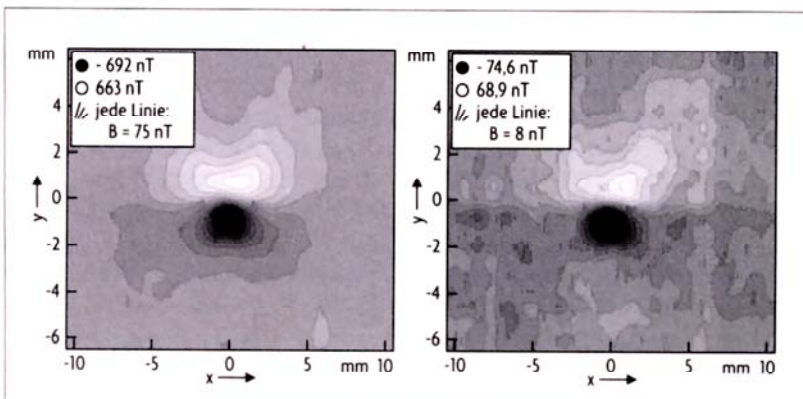
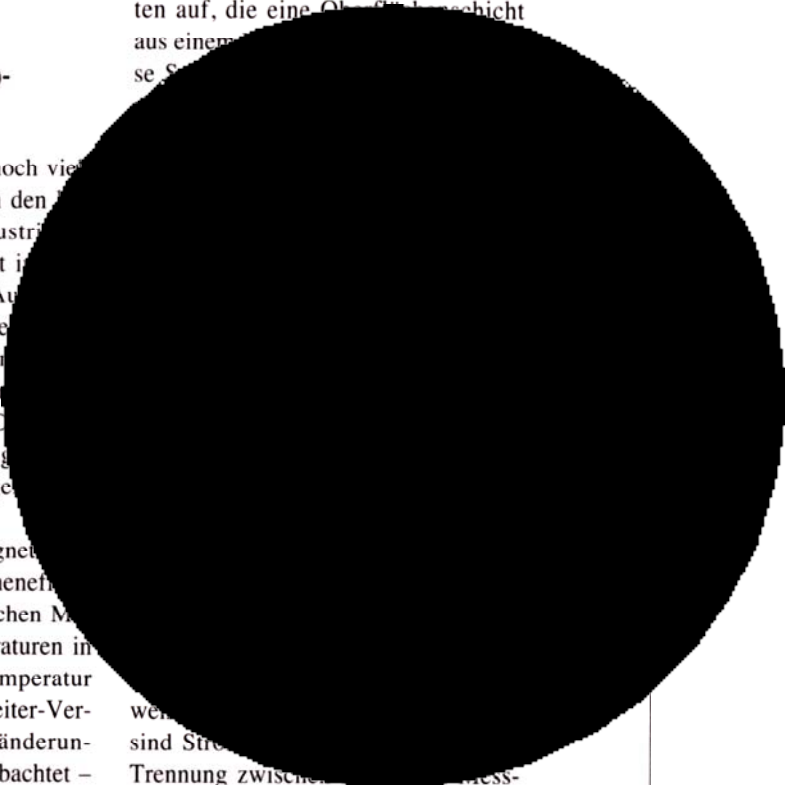


Bild 6. Zerstörungsfreie Materialprüfung mit MR-Sensoren. Hier eine AlMg₃-Laserschweißnaht. Die Defekte haben eine Tiefenlage von 0,5 mm. (Quelle: Uni Gießen, Institut für Angewandte Physik)

Ein konkretes Beispiel ist die Prüfung von Bauteilen oder mehrere Anordnungen mit Wechselstrom, wodurch eine durch das Material hindurch erzeugte magnetische Wechselfeld in das zu prüfende Objekt eingestrahlt wird. Bei Materialdefekten wie Poren, Mikrorissen oder Einschlüssen ergeben sich charakteristische Signalformen. Wenn der Sensor das Objekt zeilenweise überstreicht, lassen sich zweidimensionale Bilder gewinnen (Bild 6), die Informationen über die Materialhomogenität und eventuelle Fehler liefern. Auch ein Prüfverfahren für metallische Drähte wurde entwickelt, das mit vier kreuzförmig angeordneten Sensoren arbeitet [1].

Eine ungewöhnliche Idee für einen magnetoresistiv arbeitenden Umdrehungszähler entstand am IPHT Jena in Zusammenarbeit mit der Firma Novotechnik, Ostfildern bei Stuttgart (www.novotechnik.de). Das Sensorelement besteht aus einem etwa 200 nm brei-

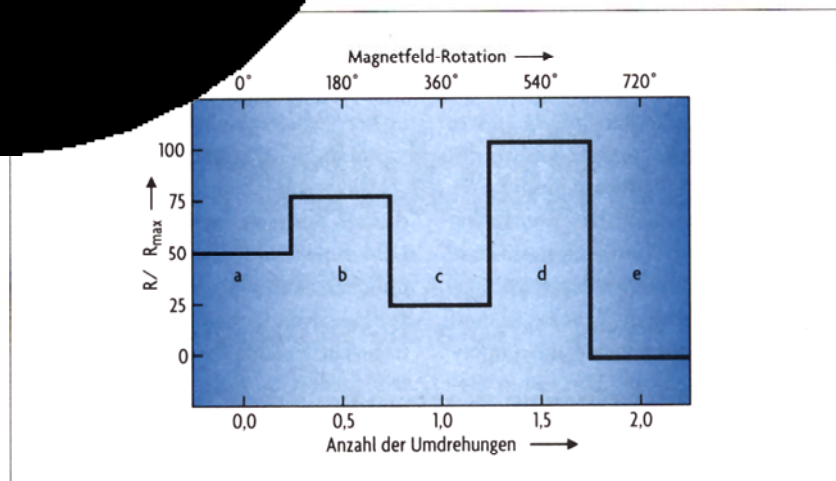


Bild 8. Zusammenhang zwischen elektrischem Widerstand und Anzahl der halben Umdrehungen bei dem GMR-Umdrehungssensor von Bild 7.

(Quelle: IPHT/Novotechnik)

ten, 40 nm dünnen GMR-Streifen (Ni81Fe19 mit Zwischenlagen), der in Form einer rennbahn-ähnlichen Spirale aufgewickelt ist, Länge etwa 500 µm. Am Ende der zu überwachenden Achse befindet sich ein Magnet mit radialer Feldrichtung. Am äußeren Ende der Spirale weitet sich der Streifen zu ei-

ner größeren Fläche von 10 µm × 15 µm auf. Dreht sich das Magnetfeld um 180°, wird in dieser eine ferromagnetische 180°-Domänenwand erzeugt. Bei jeder weiteren derartigen Drehung entsteht jeweils eine neue, und alle vorher erzeugten wandern in der Spirale um eine halbe Windung vorwärts. Die-

